

モンテカルロコード DEGAS を用いた 中性粒子輸送シミュレーションの技法

ーガンマ10への適用ー

中嶋洋輔

(筑波大学プラズマ研究センター)

Technique of Neutral Transport Simulation Using the DEGAS Monte-Carlo Code - Application to GAMMA 10 -

NAKASHIMA Yousuke

Plasma Research Center, University of Tsukuba, Tsukuba 305-8577, Japan (Received 25 June 2004)

Techniques for the neutral transport simulation using a Monte-Carlo code are briefly reviewed by explaining the examples of the simulation with the DEGAS Monte-Carlo code. Tandem mirror plasma produced in GAMMA 10 is employed as a target plasma for the simulation. An axisymmetric simulation using the ver.35 code is applied for the central-region and a three-dimensional simulation in non-axisymmetric anchor region is performed with the ver.63 code. In this review brief introduction of both versions, newly introduced processes and mesh models designed for axisymmetric and non-axisymmetric structures in the GAMMA 10 are described.

Keywords:

DEGAS, neutral transport, Monte-Carlo simulation, particle source, H α line-emission, wall recycling, atomic and molecular processes, GAMMA 10, tandem mirror

1. はじめに

磁気閉じ込め装置において,粒子・エネルギー収支を解 明し,プラズマ閉じ込め性能を向上する上で,中性粒子の 挙動は重要な研究課題である.また,プラズマ中およびそ の周辺の中性粒子密度は,リサイクリングや粒子源の強度 を評価する上で,測定すべき不可欠のプラズマパラメータ である.

プラズマを生成するには真空容器にまずガスを入射し, それが充満した頃を見計らって,電磁誘導あるいはマイク ロ波の入射により電離を起こし,それを初期プラズマとし て,ガスパフや中性粒子ビーム入射(NBI)や高周波波動 (RF)等の加熱パワーを用いて高温プラズマに立ち上げて ゆく.また,外部からプラズマ銃で初期プラズマを入射し, それにガスパフと加熱パワーを用いてビルドアップさせる 方法もある.いずれにせよ,プラズマ生成時の初期から, 高温プラズマ達成時に至るまでプラズマ中およびその周辺 には少なからぬ中性粒子が存在しており,プラズマとの相 互作用により,我々に複雑な現象を提供してくれる.プラ ズマ中の中性粒子は,高温プラズマイオンの荷電交換反応 によるエネルギー損失のターゲットであることから,過剰 な中性粒子はエネルギー損失の元凶となりうる.その反 面,中性粒子はプラズマ密度上昇を促進させるための電離 の元(粒子源)を担うものでもあり,適切な中性粒子の供給(Fueling)は効率的な高温プラズマ生成にとって必須の 手法である.

近年,ダイバータ部におけるダイバータ板への熱負荷を 評価する上で、ダイバータプラズマの輸送過程を調べるた めには、同領域における中性粒子輸送の解明は、重要な研 究課題となっている.また、トーラス系プラズマ装置にお いて近年話題となっているブロブと呼ばれる磁力線に垂直 な輸送現象や日モード閉じ込め時に形成される周辺ペデス タル構造と中性粒子の浸透の関係が重要視されている.一 方、プラズマ閉じ込め磁場の磁力線に沿った中性粒子輸送 は、ダイバータ配位や、タンデムミラー等に代表される開 放端系プラズマ閉じ込め装置の特徴として、プラズマパラ メータが大きく変化している場合が多いため、それらにつ いての十分な理解が必要とされる.このように普遍的な研 究テーマである中性粒子の挙動解析を目的として、様々な 方式のプラズマ閉じ込め研究において、中性粒子挙動を調 べる実験的あるいは理論的手法が開発されてきた.

中性粒子の挙動を実験的に調べる手法として,水素プラ ズマの場合励起された水素原子の主量子数 n = 3 から 2 へ 遷移する輻射線 (Ha 線)の発光を計測することが一般的な ものとして確立されている[1,2]. その際, Ha 線輻射強度

author's e-mail: nakashma@prc.tsukuba.ac.jp

と中性粒子密度とを結びつける分光モデルが必要とされ, 通常我々が取り扱うプラズマパラメータ領域では,衝突輻 射モデルが採用されている[3-5].後述するように,プラズ マ中からの Ha 線輻射の計測は,古くからトカマクプラズ マで行われており[6-9],今ではリサイクリングや Fueling 量を推し量る指標としても広く利用されている.

一方、中性粒子挙動を理論的なアプローチで解明するこ とは、上述の実験的手法より以前から行われており、中性 粒子に関するボルツマン輸送方程式を解くことを目的とし て,スラブ近似や円筒近似に基づいて,1次元の数値解析 が行われてきた[10,11].しかしながら,任意の複雑な形状 について解くことは非常に困難であり、しかも様々な原子 ・分子過程を取り入れた計算や壁との相互作用を考慮する ことは、実際上不可能であることから、モンテカルロ法を 用いた中性粒子輸送シミュレーションが、近年のコン ピュータ性能の向上とともに,非常に有効な手段として浮 かび上がってきた. モンテカルロ法による中性粒子輸送解 析では、後述するように数千個から数十万個のテスト粒子 をメッシュ状に区切ったシミュレーション空間(真空容器 およびプラズマ領域)中に放出し、乱数に従ってプラズマ を構成している粒子との相互作用を模擬しつつ、テスト粒 子の軌道を追跡してゆき,各セルにおけるテスト粒子の ウェイトをスコアリングすることにより、セル内の中性粒 子の密度や温度を評価する.

本解説では、モンテカルロ法を用いた中性粒子輸送シ ミュレーション解析の技法について,DEGAS モンテカル ロコードをガンマ10タンデムミラープラズマへ適用した例 をあげて述べる. 上記プラズマを適用対象とした理由は, 筆者が筑波大学プラズマ研究センターにおいてガンマ10プ ラズマの研究に従事していることが主たる理由ではある が、後述するようにタンデムミラープラズマには軸対称モ デリングが適したセントラル部と非軸対称部である極小磁 場部の両方を備えており,両部においてシミュレーション と比較すべき計測データが比較的豊富にそろっていること も理由の一つである.一方,モンテカルロコード自身の説 明については、紙面のスペースから困難であることから、 本稿では触れず、これに関するいくつかの文献にゆだねる [12,13]. またダイバータプラズマ,周辺プラズマ等のシ ミュレーションに関しては、畑山氏の執筆された2001年本 誌解説を始め、最近本誌の小特集での詳細な記事[14,15] があり、シミュレーション応用例としてのプラズマ輸送解 析に関する記事[16]が竹永氏によって書かれているので, これらについては当該文献を参照されたい.

引き続く第2節では、現行の DEGAS に至るまでの中性 粒子輸送モンテカルロコードの歴史的発展について紹介 し、入力データを始めとするシミュレーション研究に必要 な資源について概説する.第3節では、軸対称モデルとし てのガンマ10セントラル部への適用結果について述べ、第 4節ではその延長である3次元モンテカルロシミュレー ションの適用に関し、ガンマ10非軸対称極小磁場部におい て行われた解析結果について議論する.第5節では、まと めと今後の課題・展望について触れる.

2. 中性粒子輸送モンテカルロコード「DEGAS」

2.1 中性粒子輸送モンテカルロコードの歴史的発展

モンテカルロコードによる中性粒子輸送シミュレーショ ン研究としては、1970年代後半に Hughes と Post らによっ て開発された AURORA コードを用いたものが、初期の頃 の代表的なものの一つにあげられる[17]. AURORA コー ドは、円柱近似に基づいたプラズマ内の中性粒子の輸送を モンテカルロ法によって模擬するコードであり、軸対称に 作成したセル内における中性水素原子の密度や温度を計算 することができる.計算コードでは、系外から入射された テスト中性粒子は、Path Length Estimator と呼ばれるアル ゴリズムに従って,荷電交換,衝突電離,壁との相互作用 等の過程を経て、その軌跡が追跡され、最終的に各セルに 存在したテスト粒子のウェイトの総和として密度が求めら れる. その他, スプリッティングゾーンやロシアンルー レット法などのテクニックが導入され、当時としては少な いテスト粒子数 (<1,000 個) で比較的統計精度の良い計算 結果を出していた. 計算結果は, 様々なプラズマ中のイオ ン温度の測定手法である荷電交換中性粒子分析における, エネルギースペクトルの解析等に用いられた.

1980年代に入って、ダイバータ領域での中性粒子輸送を シミュレートできるコードが数多く開発されるようになっ た[12, 13, 18, 19]. その中で, DEGASはHeifetzらによって 開発されたコード[12,13]で,現在も至る所のプラズマ閉 じ込め装置における中性粒子の計算やダイバータ設計のた めに用いられている.上述の AURORA コードでは,中性 水素原子を入射して、その軌跡を追跡することによって密 度分布を計算しているのに対し、DEGAS コードでは、中 性水素分子を入射し,水素分子がプラズマ内で解離反応に より原子を生成し、それら分子と原子の両方を追跡してい る. また, DEGAS コードでは, 粒子追跡のアルゴリズムに pseudo-collision[13,20]の手法を用いており、前出の AURORA コードに比べて、テスト粒子の追跡において計 算速度等に優れ、真空中での中性粒子を追跡できるといっ た特長を持っていた. このことは、ダイバータ領域におけ る排気ダクトの設計等で中性粒子輸送のシミュレーション を行うのに好都合である.また、本コードでは水素原子・ 分子に関する様々な原子分子過程を考慮できるようになっ ている.これによって、入射粒子を水素分子として計算を 行うことができるので、より現実的な状況下でのシミュ レーションが可能となる. 文献[12]では, INTOR のダイ バータの設計例を取り上げて、D, T, Heの排気効率やダ イバータ内での ionization rate の空間分布,ダイバータ板 上の熱負荷や損耗率等の計算結果の例が示されている.

1990年代において、それまでメインフレーム (Cray Computer 等)において稼動させていた DEGAS コードは、時代 のニーズに合わせて UNIX マシンへ移植されることにな り、バージョンアップがStotler らによって進められていっ た.第4節で紹介する3次元シミュレーションは、この段 階の DEGAS ver.63[21]を用いて行っている. Stotler らは、 現在 DEGAS 2 コード[22]を新たに開発し、さらに多様な 原子分子過程および中性粒子同士の衝突等の物理モデルを 考慮したシミュレーションを可能にしている.上記物理モ デルは、昨今のダイバータモデリングに適していることか ら、プラズマの粒子、熱輸送を解くB2やUEDGE等のコー ドと結合されダイバータコードとしても使用されている.

2.2 シミュレーション解析に必要なリソース

以上概説した DEGAS コードを実際に利用するには、以 下のような方法が考えられる.最も「廉価」に利用するに は,核融合科学研究所計算機センターの汎用計算機システ ム SX-5に移植されている ver.35を用いるのがてっとり早 い. この場合には、上記研究所との共同研究の申請を行っ た上で, 公開されている本コード*1を各自の端末 (PC) か らログインしてコードを稼動させ,計算結果をFTP転送し て利用する形態をとる.ただしこのバージョンでは、スラ ブモデルを始め、円筒軸対称モデルやトロイダル対称性を 仮定したものにしか対応しないので、複雑な体系には向か ない.一方,手元に比較的高速の計算機資源がある場合, ver.63を導入する*2ことによって、3次元体系に対応する シミュレーションが可能になる.この場合には,Alphaマ シンと Compaq Fortran の組み合わせが、実用上問題のな い性能を出す. また, IntelチップベースのPCLinux システ ム+Intel Fortran も、廉価版の構成モデルとして適切であ る. 予算に糸目をつけないのであれば、Alpha チップベー スのマルチ CPU ワークステーションが現時点では最も高 性能を発揮すると思われる. この他の DEGAS のバージョ ンとして、1980年代に旧プラズマ研究所において、川村先 生のグループによって導入され,最近大阪府立大学の松浦 氏により,同計算センターSX-5上で整備された ver.45*³ や,前述の DEGAS 拡張版であり,PC上で利用可能な DE-GAS2*⁴が存在する.参考までに,国内の大学,研究所等で 使用されている各種 DEGAS のバージョンおよび動作環境 の一覧を Table 1 に示す.

2.3 解析対象とシミュレーション体系の適合性

続いて,解析しようとする対象のプラズマおよび壁等の 構成要素の幾何学的形状がどのシミュレーション体系に適 合しているかを見定める必要がある.たとえばダイバータ 板近傍における局部的な中性粒子挙動をシミュレートする 場合には、1次元のスラブモデル体系で十分な解析が可能 な場合もある.また、軸対称性の非常に高い装置のプラズ マ(ダイバータ模擬装置など)では、殆どの場合軸対称性 を仮定した円筒モデルが適当である. 単純なトーラス形状 の装置を内部に設置した様々な装置までモデル化しない場 合には、トロイダルー様性を仮定した2次元のモデルが比 較的簡単に解析が可能である.上記のモデルでは, ver.35 を用いた2次元体系の計算で事足りるが、それらに比べて 複雑な形状、例えばヘリカル装置や非軸対称形状を持つ極 小磁場配位の体系をモデリングする際や、単純な形状でも 内容物が複雑な形で存在している場合には、ver.63を用い た3次元体系での解析が必須となる.

2.4 DEGAS 計算に必要な入力パラメータ

DEGASでは、比較的小規模のver.35を用いる場合で

Institute	DEGAS / version	Computer	Memory	Operating system	Compiler	Key person
NIFS	DEGAS / ver.63	VT-Alpha 600S / 700S (Alpha21264A, 600MHz / 700MHz)	768MB / 1GB	Linux	Compaq Fortran for Linux Alpha	M. Shoji
JAERI	DEGAS / ver.35 modified by JAERI	VPP5000	512GB	UXP/V	Fortran77/VPP	H. Takenaga
	DEGAS2	IBM RS/6000 SP	4GB	AIX4.3.3	XL Fortranv8.1 for AIX	
	DEGAS2	Xeon 3GHz	2GB	Linux	Fujitsu Fortran / PGI Fortran	
	DEGAS2	Compaq Alpha (667MHz, 2cpu)	1GB	True64 UNIX	Compaq Digital fortran90	
IAE, Kyoto Univ.	DEGAS / ver.63	Compaq Alpha (667MHz, 4cpu)	4GB	Digital Unix V4.0F	Compaq Digital fortran90	S. Kobayashi
Osaka Pref. Univ.	DEGAS / ver.45	NIFS SX-5				H. Matsuura
	DEGAS / ver.63	PC(Pentium700MHz / 2.2GHz)	128MB / 1GB	Linux	Fujitsu Fortran / Intel Fortran	
	DEGAS2	PC(Pentium700MHz)	128MB	Linux	Fujitsu Fortran	
PRC, Univ. Tsukuba	DEGAS / ver.35 modified by PRC. Univ. Tsukuba	NIFS SX-5				Y. Nakashima
	DEGAS / ver.63	VT-Alpha 533 / 6 HR (Alpha21164, 533MHz / 21264B, 800MHz)	512MB / 2GB	Linux	Compaq Fortran for Linux Alpha	

Table 1 List of operating environments of DEGAS simulation carried out in some institutes of Japan.

*1 核融合科学研究所・計算機センターの汎用計算機システムにログインして, /usr/nifscc/appl/gdegasu ディレクトリの実行 ファイルを使用するか, ソースコードを/usr/nifscc/src/gdegasu ディレクトリからダウンロードした後, コンパイルして使 用する(計算機利用共同研究を予め申請してアカウントを貰っておく必要がある).

*3 核融合科学研究所・計算機センターの汎用計算機システム内の/usr/nifscc/appl/degas45ディレクトリにある.

^{*2} プリンストンプラズマ物理研究所 FTP サイト (ftp.pppl.gov)の/pub/degas ディレクトリから tar ファイルをダウンロードできる.

^{* 4} プリンストンプラズマ物理研究所のホームページ(http://w3.pppl.gov/degas2/)からソースコード,マニュアルがダウンロードできる.

も,60種類を超える入力パラメータを設定する必要があ る.このうち代表的でシミュレーション実行上注意すべき もの,後述するシミュレーション結果の際に重要となるパ ラメータについて簡単に説明を行う.

(1) テスト粒子数

文字通りシミュレーション空間内に入射して,その軌跡 を追う粒子の個数であり,通常数千個から3次元空間の比 較的大規模なシミュレーションの場合数十万個に及ぶ.ま た,この粒子数を15個程度以下にすると各テスト粒子の軌 道を出力する機能があるので,粒子が正常にメッシュ空間 内を飛行しているかどうかを確認する上で重要となる.

(2) 粒子種

通常水素しか使用していないが,重水素,三重水素も対 象となっている.

(3) テスト粒子の入射エネルギー・角度分布

ガスパフやリサイクリング等による中性粒子の入射の際 のエネルギーを定義する.通常は室温に相当するエネル ギーを入れる.また、入射粒子として中性水素原子と中性 水素分子を選択することが出来る.入射角度分布について は、通常コサイン分布の頻度で、入射粒子の角度を与える ようになっている.

(4) 壁

DEGAS上で定義できる壁の種類として,通常の壁,ミ ラー壁,出口の3種類の他に粒子源を与える中性化プレー トがある.通常の壁では,テスト粒子は壁材料に応じた反 射係数データベース[23]に基づいて反射および新たな粒子 の脱離を生じる.ミラー壁では,テスト粒子は鏡面反射を 行うので,上下や左右対称の体系では,中心にミラー壁を 定義することによって,メッシュ空間を半分に節約するこ とができる.中性化プレートは,ガスパフやリサイクリン グ領域の壁に定義することによって,テスト粒子の供給源 として用いる.複数の中性化プレートが存在する場合に は,各プレートから放出されるテスト粒子の重みを別のパ ラメータによって個別に指定できる.出口は,真空排気の ダクトなど粒子が再び戻らないと考えられる箇所に定義す る.

(5) プラズマパラメータ

DEGASでは、シミュレーション空間に定義されたセル 全てに、以下のプラズマパラメータを入力する必要があ る.電子密度は、中性粒子の平均自由行程を左右する最も 感度の高いパラメータである.電子温度は、原子分子過程 の反応率に強く影響を及ぼすため、これも重要なパラメー タとなる.特に周辺部の水素分子の密度が高い領域では、 電子温度の値が分子の解離に影響を及ぼす可能性があるた め、注意が必要である.イオン温度は、中性粒子が荷電交 換反応によって新しいエネルギーの中性粒子となる際の キーパラメータである.したがって、比較的高密度プラズ マにおいて、プラズマ中の中性粒子の平均自由行程がプラ ズマ半径に比べて短くなる状況下では、イオンと中性粒子 間のエネルギーの交換が頻繁になり、両者の温度差は小さ くなる.

以上掲げた各種入力パラメータの他にもメッシュを作成

する段階で様々なパラメータ設定を必要とするが,本解説 の範囲を逸脱するので省略する.これらのデータを入力 ファイルとして作成し,シミュレーション実行時に読み込 ませる.シミュレーション終了時に,DEGASは出力ファ イルを生成し,その中から,中性水素原子,分子の密度・ 温度等の必要な情報を抽出し,視覚化して実験データとの 比較検討を行う.

3. タンデムミラーへの適用

3.1 ガンマ10装置と Ha 線計測

第1節において述べたように、中性粒子輸送の解明は重要な研究課題となっており、開放端系においてもプラズマ 内部の中性粒子密度は、粒子バランス解析や高βプラズマ 生成のために、重要な計測対象となっている[24-27].特に タンデムミラーにおける水素リサイクリングの制御、サー マルバリア等の閉じ込め電位の維持および、密度制御のた めの適切な粒子補給の観点からも、その解明が求められて いる.本節において、DEGAS コードのタンデムミラープ ラズマへの適用結果を示す前に、簡単にガンマ10タンデム ミラー装置における中性粒子挙動に関する計測システムを 紹介しておきたい.

ガンマ10では、中性粒子の挙動を調べるためにセントラ ル部において Hα 線輻射の計測が行われ、その径方向プロ ファイルから中性粒子密度が求められてきた[28].また、 軸方向にも Hα 線検出器が設置されており、磁力線に沿っ た方向の挙動を観測している[29].これらの計測結果か ら、プラズマ維持のために入射される水素ガスがガスパフ 近傍に偏在することが明らかになっている.

ガンマ10は全長約27mの実効的軸対称化されたタンデ ムミラーであり、軸対称のプラズマ主要閉じ込め領域であ るセントラル部、極小磁場部であるアンカー部、軸方向閉 じ込めを行うプラグ・バリア部から成っている[30-33]. セントラル部の長さは6mで、ミッドプレーンの磁場強度 は通常0.41 Teslaで実験される.セントラルの両端には、ミ ラースロート部を介してアンカー部が接続される.初期プ ラズマはプラズマ銃によって両端部から入射され、ガスパ フと ICRF 波動によって、プラズマの密度制御・加熱が行



Fig. 1 Schematic view of GAMMA 10 central-cell and heating systems and diagnostics for this study.

われる.

Fig.1はガンマ10セントラル部の真空容器,Ha線計測 器、加熱系とガス導入系の概略図を示す。セントラル部の イオンは、セントラルセル両端部にあるダブルハーフター ンアンテナで励起されたイオンサイクロトロン共鳴によっ て加熱される. ガンマ10セントラル部には7個のガスパフ が設置されており、水素ガスは通常荷電交換損失を免れる ように両端より入射される.軸方向検出器は、セントラル 部ミッドプレーン近傍(z=-1 cm, -71 cm, -141 cm)の 3点とミラースロート部 (z = -307 cm) に新しく設置され ていて,各々はプラズマ中心を向いている.検出器は干渉 フィルタと光ファイバーおよび光電子増倍管で構成され, 検出された信号はCAMACシステムに転送され,最終的に ワークステーションで処理される. ガンマ10では、セント ラル部において ICRF 波動を用いたプラズマイオン加熱を 行い, ECRH により軸方向閉じ込め電位を発生し, プラズ マ閉じ込め実験を行っている.この場合,セントラル部イ オン温度が電子温度に比べて極端に高く(Te:数+eV~ 100 eV に対して、Ti:数 keV~10 keV.),イオンから衝突 緩和過程を介して電子にエネルギーが供給される状態とな



Fig. 2 Time behavior of plasma parameters obtained in typical hot-ion-mode plasma of GAMMA 10. (a) Line density of electron, (b) diamagnetism, (c) Hα line intensity of various positions.

り,このような運転モードを高イオンモードと呼んでいる [34].

Fig.2 は典型的な高イオンモードにおける, プラズマパ ラメータと Hα 線輻射強度の時間変化を示す. この実験 モードでは、2種類のガスパフが使用される。一つは初期 プラズマのスタートアップ用として,短パルスで濃いガス をガスボックス (GasBox) を用いて入射している. もう一 方のガスパフは、ミラースロート部に設置されており、プ ラズマを維持する目的で、ICRF パルスに合わせて比較的 長時間入射される. Fig. 2(c)は, 今回新設した Ha 線検出器 アレイの信号と既設の GasBox 近傍およびスロート部の H α線信号の時間変化を示す. GasBox 部の信号は通電初期に 強いピークを示していることがわかる.これは、立ち上げ 初期のGP#1bからのガス導入の影響を示している.一方, プラズマが定常維持されている時間帯では、スロート部の 発光強度が極めて高い、これはスロート近傍の中性粒子密 度分布が高く、GP#3aよりスロート部に入射されている ガスが、その近傍に局在化していることを示唆している. 定常状態時のスロート部における Ha 線放射輝度は、セン トラルミッドプレーン部の20倍以上に達している.以上の ことから、ミラースロート部へのガスパフはミラープラズ マのビルドアップにとって効果的であることが確認された. 3.2 DEGASによるガンマ10セントラル部の軸対称モデリ

ング

3.2.1 低密度プラズマへの対応(分子の解離・励起過程の 導入)[35]

前述したように,DEGAS コードとは,任意の形状をし たプラズマをメッシュ状に刻んだセルで近似することによ り,プラズマ中の中性粒子の密度・温度分布をモンテカル ロ法に基づいて求めるコードである.DEGASには,水素 原子・分子にかかわる種々の過程が考慮されている[13] が,水素分子の解離過程において,以下に示す解離反応の 際に励起にかかわる反応過程が考慮されていなかった(括 弧内の数値は解離時に持つ水素原子のエネルギーを表す).

$e^- + H_2 \rightarrow e^- + H^* + H$	(0.3 eV, 2.5 eV)
$e^- + H_2 \rightarrow e^- + H^* + H^*$	(4.85 eV)
$e^- + H_2^+ \rightarrow e^- + H^+ + H^*$	(1.5 eV)

ガンマ10のプラズマでは、通常のトカマクプラズマ装置 に比べ、電子密度が1桁程度低く、プラズマ周辺部の中性 水素分子密度が高いので、シミュレーションの過程に水素 分子の解離・励起の効果を入れるように、ガンマ10に適用 するに先だって ver.35 および、後述する ver.63 の両コード に改良を施している. DEGAS コードに以上のような改良 を加える際、励起状態にある中性水素原子が次の原子分子 過程を引き起こす前に基底状態に戻るという仮定を与えて いる. 主量子数 n が 2 ないし 3 の状態に励起した中性水素 原子は、その遷移確率から考えて各々 2 ns ないし 18 ns 程度の時定数で基底状態に戻る. 上記の解離励起過程に よって生成される中性水素原子の平均エネルギーは 0.3 か ら 4.85 eV であるので、励起した中性水素原子が基底状態 に戻るまでに、プラズマ中を 1.6~40×10⁻³ cm 進むと考え



Fig. 3 Comparison of calculated results in neutral density between 1-dimensional rate equation code and 1-dimensional DEGAS simulation.

られる[36].通常のガンマ10のプラズマパラメータから考 えて、プラズマ中の中性水素原子の平均自由行程は1~4 ×10² cm 程度となる.以上の条件下では励起した中性水素 原子が励起状態のまま、次の原子分子過程を引き起こすこ となく、速やかに基底状態にもどるという仮定が十分に成 立することがわかる.上記の仮定により、モンテカルロ コード内で励起水素原子の粒子の追跡を行う必要がなくな り、コードの改良が容易になる.

引き続いて,改良に伴う計算の妥当性を調べるために, DEGASによる計算とは別に、単純化したモデルにおいて 中性粒子密度の数値計算を行い,正常に作動していること を確認した.Fig.3はスラブ近似の1次元 Rate Equation Codeを用いた数値計算結果と、この計算に対応させるた めに1次元化した DEGASの計算結果を比較したものであ る.スラブ状の一様プラズマを仮定し、外部から水素分子 を侵入させた場合のプラズマに入る深さ方向(X方向)の 水素原子分子の密度分布を示している.ここでは3種類の プラズマ電子密度について計算を行っている.太線で表さ れているのが Rate Equation Code から求めた結果であ り、折れ線様の細線が DEGAS の計算結果である.両者は 概ね良く一致しており、水素分子の解離励起過程を導入し たアルゴリズムが正常であることが確認された.

Fig.4は、ガンマ10に適用した際のメッシュモデルを示 す.本シミュレーションでは、ガンマ10のセントラル部を 対象としているので、プラズマおよび真空容器は円筒形を 仮定しており、軸対称のメッシュモデルを作成している. また、軸方向には一様性を仮定して、両端部は鏡面として いる.一方、ガンマ10の真空容器には、カーボニゼイショ ン等の表面コーティングは施されていないので、真空容器 の側面は鉄であるとして、粒子源を側面全体に設定し、 Eckstein, Verbeek らの反射係数に基づいた水素原子の反 射効果を考慮している[22].

3.2.2 シミュレーション結果と実測値との比較

プラズマ電子密度に対する特性を調べるために行ったシ ミュレーション結果をFig.5に示す.Fig.5(a)は比較的低プ



Fig. 4 Mesh model of the central-cell used in the axisymmetric DEGAS simulation.



Fig. 5 Results of the axisymmetric DEGAS simulation. (a) Low density case, (b) high density case.

ラズマ密度の場合(線平均電子密度~2.2×10¹² cm⁻³)の水 素原子と分子密度の半径方向分布を表わしており, Fig.5 (b)は高密度の場合(同 3.6×10¹³ cm⁻³)の計算結果を示して いる.図中の破線は水素の解離励起過程を考慮していない 従来のDEGAS計算結果で,実線は改良を施したものに対 応している.両者は,プラズマ境界部での水素分子密度で 規格化している.図から低密度の計算結果での水素原子密 度に差異が現れていることがわかる.

Fig.6は、プラズマ中心部における水素原子密度 $n_{\rm H}(0)$ とプラズマ境界での値 $n_{\rm H}(a)$ の比を、プラズマ電子密度に 対してプロットしたものである.図中の●印は従来の DE-GASシミュレーション結果であり、□印は改良後のもので ある.両者は共に電子密度の上昇に伴い、 $n_{\rm H}(0)/n_{\rm H}(a)$ の値は減少しており、密度上昇によって外部からの中性粒 子の侵入が抑制されていることが示されている.しかしな がら、低密度領域では両者に差が生じており、 10^{13} cm⁻³



Fig. 6 Neutral density ratio $n_{\rm H}(0)/n_{\rm H}(a)$ as a function of the electron density.



Fig. 7 Comparison between the simulation results and the experimental result.

以下では差が顕著になる傾向が見られる.

典型的な高イオンモードプラズマ $(n_e(0) \sim 5 \times 10^{12})$ cm⁻³, T_i(0)~5 keV) において, Ha 線の空間分布計測か ら求められた中性粒子密度とシミュレーション結果とを Fig.7で比較している.計算に用いたプラズマパラメータ (ne, Te, Ti)は実際に測定された値を用いている. シミュ レーション結果は、従来の DEGAS と改良されたものの両 方を示している. 実測値を表す図中の○印は, Ha 線の発光 がすべて中性原子のみによるとした場合の中性原子密度の プロファイルを表し、△印は水素分子の解離励起時の発光 の寄与を差し引いて求めた水素原子密度を示している.従 来の DEGAS (破線) では、周辺部で Hα 線計測から求めら れる水素原子密度と差が認められるが、改良したシミュ レーション結果(実線)は、水素分子の解離励起を考慮し た実測値と極めてよく一致している.また、図中の×印は、 セントラル部真空容器に設置されている高速電離真空計で 測定された圧力を密度に換算した値を示しており、周辺部



Fig. 8 (a) 2-dimensional mesh model of the DEGAS simulation in the central-cell, (b) Comparison between the calculated results of Hα emission with DEGAS simulation and measured results.

の水素分子密度の値に対しても、大きな矛盾のないことが わかる.これらの結果は、低プラズマ密度領域では水素分 子の影響が特にプラズマ周辺領域で重要になることを示し ている.

3.2.3 軸対称円筒モデルの導入とリサイクリングの効果

実験的に観測されたガスパフ近傍に中性粒子が局在化す る結果を検討するために、DEGASの磁力線方向への拡張 を行った.磁力線方向に沿って計算できるように、新しく 作成したメッシュモデルを Fig. 8(a)に示す.計算で使用し たメッシュは、セントラル部真空容器の片側が、真空容器 およびアンテナ等の内容物を含め、軸対称を仮定して作成 されている.この計算では、ガスはミラースロート部から 注入している. Fig. 8(b)には, Hα 線放射強度に換算したシ ミュレーション結果と実測値との比較を示す. DEGAS の 結果は、スロート部の実測値で規格化している. シミュ レーション結果から, Ha 放射強度はガスを導入している スロート部に局在化しており、ミッドプレーン近傍で殆ど 一定となっている. これらはスロート部からミッドプレー ン方向へは、2本のアンテナやガスボックス等中性粒子の 輸送を妨げるものが多いため、このような減衰が生じてい ると考えられ, 定性的に実測結果と一致している. しかし ながら、ミッドプレーン付近では計算値が実測値に比べて 1桁程度低くなっており、明らかに不一致が認められる.

上記の不一致の原因の一つとして,セントラル部中央付 近で起こっている水素リサイクリングが考えられる.ガン マ10セントラル部のミッドプレーンには,イオン加熱のた めのイオンサイクロトロン共鳴領域が存在しており,通常 の高イオンモードのプラズマではイオン温度が数keVまで 加熱されている. この高温イオンが荷電交換によって生じ る高エネルギー中性粒子の引き起こすリサイクリングの影 響が無視できない. 今までのガンマ10におけるリサイクリ ングの研究では,セントラル部のリサイクリング係数(壁 に入射した荷電交換中性粒子数に対する壁から放出される 粒子数の割合)が1以上であることがわかっている [35,37,38].一方,DEGASコードでは,通常リサイクリン グ係数を1とした計算が行われる.そこで,今回リサイク リング係数を1以外としたシミュレーションを試みた. DEGASに1以上のリサイクリングの過程を導入するに当 たって,取りあえず粒子追跡のアルゴリズム中で,壁に入 射した粒子の反射過程を無視して水素分子の脱離過程のみ を抽出し,その脱離粒子のウェイトを増やすことにより, 擬似的に1以上のリサイクリング係数を与えたシミュレー ションを行った[39].

Fig.9は、脱離粒子に与えたリサイクリング係数 $a \ge 1.0$ から 2.5 まで変化させた場合の軸方向に沿った各部の水素 原子密度の半径方向プロファイルを示す. ガスパフ近傍で あるスロート部 (z = -307 cm, Fig.9(a))では a の変化に 対して密度分布に大きな違いが認められない. しかし, GasBox 付近 (z = -240 cm, Fig.9(b))では, a の値が増加 するに従って,径方向分布の形状は変化せずに,その絶対 値が上昇していることがわかる. ミッドプレーン近傍で は、さらにその傾向が強くなっている. この結果から、擬 似的にリサイクリング量を増加させた場合,径方向分布に 与える影響に比べて,軸方向に大きく影響を与えることが 示唆される.

Fig. 10 に,計算結果に基づいて Ha 線の放射強度に換算 した軸方向分布および参考として実測値も併せてプロット している.この計算では,壁における入射粒子の反射の過 程は Eckstein, Verbeek の反射係数[22]を用い,反射を起 こさずに脱離した粒子のみにリサイクリング係数を与えて 計算を行っている.a の値が大きくなるにつれて,Ha 線の 放射強度の軸方向に沿った減衰の程度が抑制され,結果と してミッドプレーン付近の放射強度が高くなっている.ま た,図中の太い実線は,リサイクリングの原因と考えられ る高イオンの存在領域を考慮して,a に軸方向分布を与え て計算したもので,実測値を良く再現できていることがわ かる.



Fig. 9 Radial profile of atomic hydrogen density calculated by the DEGAS code in the cases with enhanced reflection factor.

以上の結果から、軸方向の中性粒子輸送には、リサイク リングによる壁からの粒子供給が大きな影響を及ぼしてい ることがわかる.実際プラズマでは、軸方向にイオン温度 が分布を持っているため、リサイクリングについてもミッ ドプレーンとスロート部で、その程度に差があると考えら れる.したがって、今後はリサイクリング係数の軸方向分 布を考慮に入れたシミュレーションが必要である.

3.3 粒子源の検討

上で述べたように、セントラル部ミッドプレーンの Ha 線強度を実測値と合わせるためには、ミッドプレーン周辺 に強いリサイクリングに起因する粒子源を考慮する必要が あった. セントラル部ミッドプレーンには内径 36 cm のリ ミタが設置されており、プラズマの最外殻は、この口径で 決定されている.一方,高イオンモードプラズマの径方向 分布は、必ずしもこのリミタに対応してはおらず、通常 もっとピーキングした分布を呈している. したがってリミ タは、トカマクのリミタやダイバータ板のように荷電粒子 が衝突し中性ガスを発生するような粒子源とは考えにく い. ガンマ10では、セントラル部におけるプラズマと壁と の相互作用は、荷電交換中性粒子が真空容器内壁を衝撃 し、その結果脱離ガスが発生してリサイクリングの源とな ると考えられている.ここでは,通常粒子源とは考えられ ていないリミタも含めて、リサイクリングに起因する粒子 源であると仮定した場合の計算を試みた[40].

Fig. 11 に,セントラル部ミッドプレーン付近の真空容器 壁および,リミタ側面上に粒子源を設定した場合のシミュ レーション結果を実測値とともに示す.ここでは,通常の ミラースロート部ガスパフに対応する粒子源に加えて, ミッドプレーン近傍 (*z* ≥ -100 cm)とリミタ側面の2ヶ所 に粒子源を設定し,各々の粒子源のウェイトをいくつか変 更することによって,実測値を再現するような組み合わせ を探した.図からわかるようにスロート部の粒子源に対し て25%のリミタ上の粒子源を与えることで,実測値を概ね 再現できることがわかった.

このことから,真空容器内壁に一様なリサイクリングに よる粒子源を与えても,リミタ部周辺に局在化した粒子源



Fig. 10 Axial profile of $H\alpha$ intensity calculated with DEGAS compared with the measured results.



Fig. 11 Simulation results with the particle source on the limiter compared with the measurements.

を与えても実験を説明できるため、現状ではどちらがより 現実的な粒子源を反映しているかを決定できない.リミタ からの粒子源の比率をリミタへの粒子束強度測定など、独 立した計測結果から導き出すことができれば、この疑問を 解明するための重要な判断材料となると考えられる.

4. 非軸対称プラズマへの適用

4.1 DEGAS ver.63による3次元モンテカルロ計算(ガン マ10非軸対称アンカー部への適用)

前節では, DEGAS ver.35を用いた1次元無限円柱と軸 対称円筒モデルにおける中性粒子輸送シミュレーションの 結果を紹介した.本節では, UNIX版 DEGAS ver.63による 3次元計算の結果[41, 42]について述べる.

Fig. 12 に, ガンマ10非軸対称極小磁場アンカー部におけ るメッシュモデルを示す.図に示すように,本モデルでは 上下対称性を導入しており,メッシュセルはプラズマの半 径方向に11個,周方向には8個に分割されている.また磁 力線に沿った2軸方向には41個の領域に分割している.今 回行ったシミュレーションでは,NBIは用いていないた め,粒子源としてミラースロート部のガスパフに加えて, アンカー部外側変換部に設置されているプラズマ中に挿入 されている可動リミタ(MLO)を模擬した粒子源を与えて いる.

ver.63を用いるシミュレーションでもver.35と同じプラ ズマの情報(ne, Te, Ti)が必要とされるが、実験で得ら れているアンカー部でのプラズマパラメータは非常に限ら れており、計算に用いる3次元化されたデータを得るため には、幾つかの仮定を導入する必要がある.電子密度の空 間分布については、以下に示すような典型的な2種類のモ デルを採用した.

シミュレーションに用いられたプラズマ電子密度の(y - z 平面)空間分布を Fig. 13 に示す.一つは, Fig. 13(a) のように,セントラル部からアンカー部へ向かって流出す るプラズマを仮定して,粒子束が保存するような条件で磁 力線方向に変化する磁場強度を考慮した密度をモデリング した.もう一方は,磁場変換部の小さいミラー磁場に捕捉



Fig. 12 Mesh model of 3-d DEGAS simulation in the GAMMA 10 anchor-cell. (a) Vacuum vessel wall, (b) the wall surface, (c) the plasma surface, (d) cross-section view of the mesh.



Fig. 13 Spatial profile of electron density used in 3-d DEGAS simulation. (a) Flux conservation model, (b) uniform density model.

された粒子の効果を考慮して、軸上密度がアンカー中央部 付近まで一定の分布を Fig. 13(b)のように仮定した. いずれ も、アンカーミッドプレーン部の ICRF 加熱による粒子捕 捉の効果を考慮し、セントラル部密度分布に基づいた、ミ ラースロート、アンカーミッドプレーンのプラズマ中心 コードの線密度を考慮して,磁力管の形状に対応させて密 度分布を決定している.

4.2 シミュレーション結果

Fig. 14 は、ミラースロート部のガスパフおよびアンカー 部外側変換部に設置された可動リミタを粒子源として両方 から粒子を放出したシミュレーション結果を示す. 計算さ れた結果は、ミラースロート部とアンカー外側変換部にお いて測定された Ha 線計測結果に一致するように規格化さ れている. Fig. 14(a)に示すように、水素分子密度の径方向 分布は周辺部に対して数十分の1から2桁減衰し、軸方向 へはアンカーミッドプレーンへ向けてさらに大きく減衰す る. 中性粒子の浸透はプラズマの厚みが薄くなった周辺領 域で起こっている.このことは、ガスパフから注入された ガスはアンカー内側変換部を経て大きく減衰し、一部のみ アンカーミッドプレーンへ到達していることを示してい る.分子密度とは対照的に, Fig. 14(b)に示す水素原子密度 はプラズマのコア領域に集中している傾向を持つ.また, 水素原子はプラズマ断面が扁平になった内側・外側変換部 においてほぼ均質な密度分布を呈している. この機構は詳 細には明らかになっていないが、フランクーコンドン中性 粒子のプラズマ厚みに比して長い平均自由行程がこのよう な中性粒子密度分布の形成に重要な役割を果たしていると 考えられる.

Fig. 15 は、シミュレーション結果から導出された Ha 線強度と実験から得られた結果を比較している.図から、 両者共に実測値を良く反映しているが、アンカーミッドプ レーンでは、Fig. 13(a)に示した密度モデルが、実測値をよ り正確に反映しているころがわかる.このように、ミラー スロート部ガスパフと外側変換部可動リミタからの粒子源 を仮定することによって、Ha 線強度の測定値の軸方向分 布を上手く再現することができた.以上のことから、水素 リサイクリングはアンカー部非軸対称部において中性粒子 の挙動に重要な役割を果たしていることが明らかになっ



Fig. 14 Simulation results obtained from 3-d simulation in the anchor-cell.

た.

4.3 3次元モンテカルロ計算上の留意点

以上,3次元中性粒子輸送シミュレーションの計算結果 を実験との比較と粒子源の場所とその強度の観点で述べて きたが,これ以外に3次元シミュレーションを行う上で留 意すべき技法をいくつかあげておきたい.

真空容器内には, 第1壁の他に様々な内容物が存在して いる.たとえばトロイダル装置であれば, RF加熱用のアン テナやポロイダルリミタ,あるいはポンプリミタ等トロイ ダル方向の一様性を乱すいくつかの機器が設置されてい る. 直線型のタンデムミラー装置においても、ガンマ10セ ントラル部には ICRF 加熱用アンテナや前述のリミタ,ガ スを局在化させるためのガスボックスなどが設置されてい る. これらの大部分はプラズマに近接して設置されている 場合が多いことから、中性粒子輸送に影響を及ぼすことが 懸念される.したがってこれらをできる限り現実に忠実に シミュレーション空間内に再現するためには,第1壁以外 に第2,第3の壁を定義する必要がある. DEGAS ver.63で は,適用開始以来,この第2壁の定義に成功していなかっ た. そのために、ガンマ10セントラル部における ver.63 コードによるモデリングができていなかったが、最近コー ドに改良を加えることにより第1壁内に複数の独立した壁 を定義、正常にシミュレーションコードを稼動させること に成功した[42]. Fig. 16 にガンマ10セントラル部の真空容 器と第2壁として定義した機器のメッシュモデルを示す. このモデルを用いて、テスト粒子を第1壁内部に発射し、 第2壁表面での粒子の反射を確認した.

また、この他の技法として、トロイダル装置においてト ロイダル方向に周期性のある構造を持った装置に適用可能 な特殊な壁を定義することが可能である.たとえばヘリカ ル装置などでは、真空容器やプラズマ断面形状が、ヘリカ ルコイルのピッチに対応した周期性をもっていることがわ かっている.このような体系では、ヘリカルコイルの1 ピッチ分のシミュレーション空間を作製し、その中でテス ト粒子を発射しその軌跡を追跡することができればトーラ ス1周分を作製せずにシミュレーションが可能となる.こ



Fig. 15 Comparison between the measured $H\alpha$ intensity and simulated one in the anchor-cell.



Fig. 16 A new mesh model of 3-d DEGAS simulation in the central-cell in which the 2nd wall is defined.

の時,一方の壁から発射されたテスト粒子が,1ピッチ分 トロイダル方向に進んで,もう一方の壁に衝突した際,単 純に反射させるのではなく,衝突時におけるテスト粒子の 速度ベクトルを維持したまま元のトロイダル位置に戻して 飛行を続けさせる必要がある.Fig.17に,上記手法を取り 入れたヘリカル装置LHDの3次元シミュレーションの メッシュモデル[43]を示す.また,ヘリオトロンJ装置で はトロイダル一周のモデリングに成功しており,作成され たメッシュモデルをFig.18に示す[44].この他にも,3次 元化されることによって,粒子源をさらに複雑に現実的な 形状に定義することが可能になり,ガスパフイメージング (GPI)実験[45,46]時のシミュレーション解析[47]やNBI 時のビームライン近傍の中性粒子挙動などの詳細解析が可 能となる.

5. まとめと今後の課題

モンテカルロコードを用いた中性粒子輸送解析は,今日 コンピュータの高性能化に伴って,より精密に現実的・定 量的解析が可能な段階に来ている.特に3次元モンテカル ロ計算は,ここ1~2年で急速な進歩を遂げ,国内におい ても,前節で述べたような完全3次元化された体系での中 性粒子輸送シミュレーションが開始されている[41-43]. しかしながら,シミュレーション空間がより現実的で詳細 になればなるほど,制作するメッシュの整合性・一貫性の 検証が困難になってくる.3次元のメッシュの制作には, メッシュ作製ソフトウェアが必須となり,その結果出来上 がったメッシュがシミュレーション空間を隙間なく埋め尽 くし,プラズマセルと矛盾なく整合しているかを調べるた めには多大な時間と労力を必要とする.

さらに,得られた結果をどのように視覚化するかも重要 な検討課題である.3次元空間内に分布した情報は,当然 のことながらそれ自体で4次元のデータ空間を占める.こ れを2次元の紙面上に適切に情報を展開・表現するために



Fig. 17 Mesh model of LHD for 3-d DEGAS simulation [41]. Thin lines in the vacuum vessel wall represent the tracks of test particles.



Fig. 18 Mesh model of the Heliotron-J device for 3-d DEGAS simulation [42].

は、様々な工夫が必要であり、それらのニーズに適切に対応する視覚化ソフトウェアをどのように選択するかは、効率的なシミュレーション研究を進める上で重要である.現状のソフトウェアでは、限られた予算、時間内にそれらを 習得するには、敷居の高いものも多く、一度使い始めると なかなかそのソフトを手放せなくなることも多いので、些 細なことではあるが、初期の選択が非常に重要となる.

一方,このような詳細な3次元シミュレーションでは, コンピュータの高性能化が進んでいるとはいえ,まだ多大 な計算時間を費やしているのが現状である.特にダイバー タコードと結合させたモデリング計算など100時間を超え る計算時間が要求される.また,それに伴って計算のデー タベースである原子分子過程および,中性粒子と壁との相 互作用データの完備が急務の課題となっている.特に,ダ イバータ領域における,非接触プラズマ状態を含めたダイ バータプラズマの理解を進める上で,この領域における特 有の素過程のデータベースの充実が必要であろう.

以上,簡単なまとめといくつかの課題を述べてきたが, 今後コンピュータの性能の向上とシミュレーションの基礎 となる素過程データベース,それらを支えるソフトウェア 群の充実により,この分野の進展とその重要性が増すもの と期待される.

謝辞

DEGAS を用いた中性粒子輸送の研究の開始に当たり コードの利用許可と導入について尽力いただいた元プリン ストン物理学研究所のD.E. Post博士および,同研究所のD. P. Stotler 博士に感謝致します. また, 当時 DEGAS ver.35 がCRAY コンピュータ用にコーディングされていたもの を、国産コンピュータ(FACOM)への移植に尽力された当 時京都大学へリオトロン核融合研究センターの大引得弘教 授および、ガンマ10へ適用する際にもご助力いただいた現 大阪府立大学の松浦寛人助手、そして筑波大の院生時代か らガンマ10における初期バージョンの軸対称化モデルの計 算を手がけ,核融合科学研究所に移られてからも3次元モ ンテカルロ計算において多大なるご協力をいただいている 庄司 主助手に深く感謝致します. そして同じく院生時代 に DEGAS を用いてガンマ10における中性粒子輸送研究に 携わった京都大学の小林進二助手をはじめ、卒業生の深澤 崇浩氏,現大学院生の東園雄太君に多大な協力をいただき ました. ここに感謝いたします. 最後に本原稿をまとめる にあたり数多くの助言をいただきました筑波大学プラズマ 研究センター立松芳典講師に大変感謝致します.

参考文献

- [1] S.A. Cohen, *Physics of Plasma-Wall Interactions in Controlled Fusion*, Eds. D.E. Post and R. Behrisch (Plenum Press, New York 1986) p.773.
- [2] D.H. McNeal, J. Nucl. Mater. 162-164, 476 (1989).
- [3] L.C. Johnson and E. Hinnov, J. Quant. Spectr. Rad. Trans. 13, 333 (1973).
- [4] プラズマ・核融合学会編:プラズマ診断の基礎 (名古 屋大学出版会, 1990).
- [5] M. Goto, I. Murakami and T. Fujimoto, J. Plasma Fusion Res. **79-80** (2003-2004) *in Japanese*.
- [6] E.I. Kuzunetsov and N.D. Vinogradova, Sov. Phys. JETP Lett. 8, 34 (1968).
- [7] N.D. Vinogradova and K.A. Razumova, JETP Lett. 19, 156 (1974).
- [8] E.S. Marmar et al., J. Nucl. Mater. 76&77, 59 (1978).
- [9] G.M. McCracken *et al.*, Nucl. Fusion 18, 35 (1978).
- [10] O.V. Konstantinov and V.I. Perel, Sov. J. Plasma Phys. 5, 1403 (1961).
- [11] C. Mercier and F. Werkoff, Proc. 6th Int. Conf. Berchtesgaden 1976 IAEA CN-35/B8-1, Vol.2, 29 (1977).
- [12] D.B. Heifetz et al., J. Comp. Phys. 46, 309 (1982).
- [13] D.B. Heifetz, *Physics of Plasma-Wall Interactions in Controlled Fusion*, Eds. D.E. Post and R. Behrisch (Plenum Press, New York 1986) p.695.
- [14] A. Hatakeyama, J. Plasma Fusion Res. 77, 420 (2001) in Japanese.
- [15] A. Hatakeyama, J. Plasma Fusion Res. 80, 205 (2004) in Japanese.
- [16] H. Takenaga, J. Plasma Fusion Res. 79, 790 (2003) in Japanese.
- [17] M.H. Hughes and D.E. Post, J. Comp. Phys. 28, 43 (1987).
- [18] E. Cupini et al., NET Report, EUR XII 324/9 (1983).
- [19] D. Reiter et al., J. Nucl. Mater. 128&129, 458 (1984).
- [20] A.S. Kukushkin, V.I. Pistunovichi and S.V. Utvinski, IAEA-CN-35/B4, Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research, IAEA, Vienna, Austria (1977).
- [21] D.P. Stotler et al., Phys. Plasmas 3, 4084 (1996).
- [22] D.P. Stotler et al., Contrib. Plasma Phys. 40, 221 (2000).

- [23] W. Eckstein and H. Verbeek, Max Planck Institute für Plasmaphysik, IPP-9/32 (1979).
- [24] S.L. Allen, D.L. Correll, D.N. Hill *et al.*, Nucl. Fusion 27, 2139 (1987).
- [25] R.A. Breun, D.A. Brouchous, J. R. Conrad *et al.*, J. Vac. Sci. Technol. A5, 265 (1987).
- [26] R.S. Post, K. Brau et al., J. Nucl. Mater. 145-147, 81 (1987).
- [27] Y. Nakashima, N. Yamaguchi, K. Yatsu *et al.*, J. Nucl. Mater. 220-222, 580 (1995).
- [28] N. Yamaguchi, S. Adachi, T. Cho et al., Proc. 15th Europ. Conf. on Controlled Fusion and Plasma Heating (Dubrovnik, 1988) Vol.12B part II p.593.
- [29] Y. Nakashima et al., J. Nucl. Mater. 241-243, 1011 (1997).
- [30] M. Inutake et al., Phys. Rev. Lett. 55, 939 (1985).
- [31] T. Tamano et al., Proc. 15th Int. Conf. on Plasma Phys. and Controlled Nucl. Fusion Research, Seville, 1994 (IAEA, Vienna, 1995) Vol. 2, p.399
- [32] K. Yatsu et al., J. Plasma Fusion Res. 74, 844 (1998).
- [33] K. Yatsu et al., Nucl. Fusion 43 No.5, 358 (2003).
- [34] T. Tamano, Trans. Fusion Technol. 27, 111 (1995).
- [35] Y. Nakashima, K. Yatsu, K. Tsuchiya *et al.*, J. Nucl. Mater. 196-198, 493 (1992).
- [36] R.K. Janev, W.D. Langer, K. Evans, Jr. and D.E. Post, Jr., *Elementary Processes in Hydrogen-Helium Plasmas* (Springer, Berlin, 1987).
- [37] K. Yatsu, Y. Nakashima *et al.*, J. Nucl. Mater. **176&177**, 404 (1990).
- [38] K. Tsuchiya, Y. Nakashima *et al.*, Jpn. J. Appl. Phys. 34, 3689 (1995).
- [39] S. Kobayashi, Y. Nakashima *et al.*, J. Nucl. Mater. 266-269, 566 (1999).
- [40] S. Kobayashi, Y. Nakashima *et al.*, J. Plasma Fusion Res. SERIES 3, 303 (2000).
- [41] Y. Nakashima *et al., to be published in* J. Plasma Fusion Res. SERIES **6** (2004).
- [42] Y. Nakashima et al., submitted to J. Nucl. Mater.
- [43] M. Shoji *et al., to be published in* J. Plasma Fusion Res. SE-RIES **6** (2004).
- [44] S. Kobayashi et al., Proc. 31th EPS Conf. Plasma Phys. (London, 2004) P5-097.
- [45] S.J. Zweben et al., Phys. Plasmas 9, 1981 (2002).
- [46] J.L. Terry et al., J. Nucl. Mater. 290-293, 757 (2001).
- [47] D.P. Stotler et al., J. Nucl. Mater. 313-316, 1066 (2003).



和歌山県出身,京都大学大 学院工学研究科博士課程を 終了後,筑波大学プラズマ 研究センターに勤務.1984 年工学博士,2000年助教 授,現在に至る.主な研究 分野は,タンデムミラーに おける中性粒子ビームを用

いたプラズマ加熱・電位形成の物理,中性粒子計測と輸送解 析,プラズマ・壁相互作用と多岐にわたる.趣味も音楽(楽 器演奏)からスキー・テニスと多岐にわたる.最近は息子と サッカーに夢中.